

檔案：
保存年限：

正本

中華民國台灣半導體產業協會 函

機關地址:新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 53 館 802 室
聯絡人及電話: 石英堂協理, 03-5917092

受文者：國立清華大學

速別：最速件

密等及解密條件：無

發文日期：中華民國一一四年十月十六日

發文字號：（一一四）導協字第〇五八號

附件：2026 TSIA 半導體設備創新獎申請辦法、申請表與推薦函

主旨：檢送本會 2026「TSIA 半導體設備創新獎」申請辦法與申請表等相關附件，請 惠予公布並推薦優秀博士、碩士研究生或研究實驗室或研究團隊參選。

說明：

- 一、本會為獎勵國內傑出博士、碩士或研究團隊積極從事半導體設備相關之研究、發明、優化或致力投入產業合作並有具體貢獻之個人或團隊，特舉辦 2026「TSIA 半導體設備創新獎」選拔活動。
- 二、檢附相關申請辦法、申請表、推薦函等文件，惠請公布並推薦 貴校優秀之士、碩士研究生或研究實驗室或研究團隊參選。
- 三、依據申請辦法第八條推薦方式，8-1 說明，各校依第三項規定向本會推薦最多 2 名(組) 士、碩士研究生或研究實驗室或研究團。
- 四、受理申請日期為 2025 年 10 月 15 日至 2025 年 12 月 20 日止。請於上述截止日前，依申請辦法相關規定請連結網址 <https://forms.gle/dorE7duo7nhRwwqi8>，填寫基本資料，並將 9-1~9-5 推薦資料文件掃描為單一 PDF 檔案後請寄至本會以利建



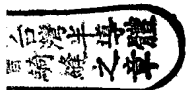


檔。聯絡資訊請參見申請辦法第十三項規定。

五、得獎名單將於 2026 年 3 月公布於本會官網www.tsia.org.tw並通知貴校。

正本：國立臺灣大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、國立成功大學、國立中央大學、國立中正大學、國立中興大學、國立中山大學，國立台北科技大學、國立臺灣科技大學、國立高雄科技大學、國立聯合科技大學、逢甲大學

副本：中華民國台灣半導體產業協會



理事長 洪永清

TSIA 半導體設備創新獎申請辦法

民國 114 年 9 月 15 日訂定

一、目的：

台灣半導體產業協會(以下稱本會)為獎勵國內傑出博士、碩士或研究團隊積極從事半導體設備相關之研究、發明、優化或致力投入產業合作並有具體貢獻之個人或團隊，特訂定本辦法。

二、獎項：

「TSIA 半導體設備創新獎」上限 3 名(組)，每名(組)頒給獎狀乙只及獎金新台幣 10 萬元整，並將其貢獻事蹟公告予本會之會員廠商並發表讓社會知悉。

三、申請資格：

3-1 國立臺灣大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、國立成功大學、國立中央大學、國立中正大學、國立中興大學、國立中山大學，國立台北科技大學、國立臺灣科技大學、國立高雄科技大學、國立聯合科技大學、逢甲大學等共十三所大學之博士研究生或實驗室，未來將陸續推廣至其它公私立大學。

3-2 已通過博士資格考之博士、碩士或致力於半導體設備相關創新優化之團體(實驗室)。

3-3 由學校推薦者。

四、申請時間：

本會於每年 10 月上旬函告各校並開放受理申請。受理申請時間為每年 10 月 15 日至 12 月 15 日止。

五、遴選委員會：

由台灣半導體產業協會設備委員會主委為遴選委員會主委或委任，並邀請在半導體領域已有卓越成就之學者、專家及產業領導者為委員。

六、頒獎日期：

於次年之本會會員大會或年會中頒獎，獲獎者須親自出席受獎。因故經設備創新獎遴選委員會同意，理監事會核備，同意由其指導教授或該單位最高研發主管出席，受獎得改由他人代之。

七、申請方式：

7-1 申請者備妥申請文件，向各校校方提出申請，經學校評鑑審核比賽後，推薦優勝者；本會不直接受理申請。

7-2 請各校於申請截止日期前，向本會推薦。

八、推薦方式：

8-1 各校依第三項規定向本會推薦最多 2 名(組)個人或研究團體(實驗室)。TSIA 創新設備獎遴選委員會針對各校推薦名單進行初選及複選兩次評選：每校得獎人最多 1 名(組)，上限共計 3 名(組)，即為得獎人。若複選仍無法選出得獎人，則增口試會議定之。為鼓勵科大積極從事半導體設備創新優化或研究，每年得保留(上限)2 名(組)保障名額。

8-2 若上述申請推薦內容或過程中，有違反事實之情事發生並經查明屬實，本會得撤銷其獲獎資格及獎項。

九、申請文件：

9-1 申請表正本(有制式表格，請向各校索取-附件一) (此為最重要文件，請務必簡潔明確)。

9-2 推薦函正本(有制式表格，請向各校索取-附件二)。

9-3 學生證及身份證正反面影本各乙份(請黏貼於申請表內)。(為保護個資，請自行加註“影本僅限 TSIA 辦理半導體獎申請使用，禁止其他用途”。)

9-4 博士班修習期間成績單正本。

9-5 團體(實驗室)以教授或博後研究生或博士生帶領 1-3 個碩士生為一單位，由指導者或一位代表人提出申請。

9-5 參與實驗主軸策略與已解決方案的具體成果和貢獻、發明成果、獲獎紀錄、專利榮譽、特殊貢獻、產學合作、著作論文、半導體學術研究等傑出事蹟之相關佐證資料。

9-6 申請文件請掃描為單一 PDF 檔案後，上傳至申請表內之申請資料連結網址，以利建檔。

十、遴選方式：

由 TSIA 設備創新獎遴選委員會執行。

十一、其它：

本申請辦法由 TSIA 設備創新獎遴選委員會訂定，經 TSIA 理監事會核備後實施，日後若有修訂，亦同。

十二、若有未盡事宜，本會保留本辦法之變更、解釋及修訂之權利。

十三、聯絡資訊：

石英堂協理/TSIA

電話：(0) 03-5917092

email:celia@tsia.org.tw



附件一、「TSIA 半導體設備創新獎」申請表

申請編號 (由本會填寫)		申請日期 (西元年/月/日)	
-----------------	--	-------------------	--

一、個人或代表人基本資料：

學校名稱	(中文)		
	(英文)		
系所名稱	(中文)		
	(英文)		
申請人	(中文姓名)		(英文姓名)
身份證字號		生日	西元 年 月 日
戶籍地址			
通訊地址	(含 6 碼郵遞區號)		
電話	(市話) (手機)	Email	

二、學歷狀況：(個人申請請依最高學歷往下填寫)

學位	學校	科系	修習期間 (西元年/月~西元年/月)

三、工作經歷：(個人申請若有請填寫，並依最近工作經歷往下填寫)

任職公司	部門/職位	工作內容	任職期間 (西元年/月~西元年/月)

四、團隊成員：(團隊申請請填寫，含申請者最多四人)

學校/系所	學歷/學位	姓名	團隊中角色說明

五、研究績效(含論文著作、專利發明、軟體、產品、產學合作、獲獎紀錄等)，依重要性排序，最多 8 項，每項扼要敘述最多 5 行。

- 1.
- 2.
- 3.
- .
- .

六、可供徵詢之專家資料

姓名	服務單位/職稱	電話(公司/手機)	Email	與申請者之關係

七、自傳或團隊介紹(500 字內)

八、自述研究成果或貢獻及其重要性(500 字內，請與“四、研究績效”之項目順序相符，並可將相關項目合併陳述其整體之貢獻與重要性)



九、身份證及學生證正反面影本

身份證正面黏貼處

身份證反面黏貼處

身份證正面黏貼處

身份證反面黏貼處

身份證正面黏貼處

身份證反面黏貼處

身份證正面黏貼處

身份證反面黏貼處

學生證正面黏貼處

學生證反面黏貼處

學生證正面黏貼處

學生證反面黏貼處

學生證正面黏貼處	學生證反面黏貼處
學生證正面黏貼處	學生證反面黏貼處

十、應備文件點檢表：

項目	請打“v”	文件名稱
10-1		申請表正本(有制式表格，請向各校索取-附件一)。
10-2		推薦函正本(有制式表格，請向各校索取-附件二)。
10-3		身份證正反面影本各乙份(請貼於本申請表)。
10-4		工作服務證明正本。
10-5		取得博士學位後，參與半導體學術研究、著作論文、發明成果、獲獎紀錄、專利榮譽、特殊貢獻、產學合作等傑出事蹟之相關佐證資料。
10-6		請連結網址 https://forms.gle/dorE7duo7nhRwwqi8 ，填寫基本資料，並將 10-1~10-5 文件掃描為單一 PDF 檔案後上傳，以利建檔。



附件二、「TSIA 半導體設備創新獎」推薦函

一、被推薦人資料

學校		系所	
姓名		姓名	
姓名		姓名	
代表人電話	(手機)	Email	
通訊地址	(含 6 碼郵遞區號)		

二、推薦人資料

任職機構		任職部門	
姓名		職稱	
電話	(市話) (手機)	Email	
通訊地址	(含 6 碼郵遞區號)		
與被推薦人的關係			

三、推薦理由

--

推薦人簽名：

日期： 年 月 日